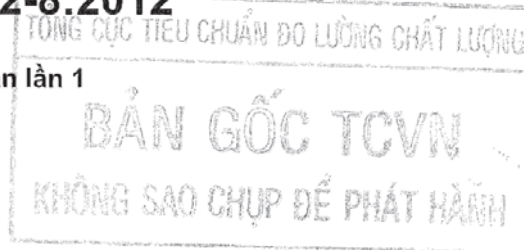


TCVN 11342-8:2016

IEC 62132-8:2012

Xuất bản lần 1



**MẠCH TÍCH HỢP –
ĐO MIỄN NHIỄM ĐIỆN TỪ –
PHẦN 8: ĐO MIỄN NHIỄM BỨC XẠ –
PHƯƠNG PHÁP MẠCH DẢI IC**

*Integrated circuits – Measurement of electromagnetic immunity –
Part 8: Measurement of radiated immunity – IC stripline method*

Mục lục

	Trang
Lời nói đầu	4
1 Phạm vi áp dụng	5
2 Tài liệu viện dẫn	5
3 Thuật ngữ và định nghĩa	5
4 Yêu cầu chung	6
5 Điều kiện thử nghiệm	7
6 Thiết bị thử nghiệm	7
7 Bố trí thử nghiệm	8
8 Quy trình thử nghiệm	9
9 Báo cáo thử nghiệm	11
10 Mức chấp nhận miễn nhiễm RF	11
Phụ lục A (quy định) – Xác định cường độ trường	12
Phụ lục B (quy định) – Mô tả mạch dải IC	15
Phụ lục C (tham khảo) – Giới hạn hình học mạch dải kín	18
Thư mục tài liệu tham khảo	23

Lời nói đầu

TCVN 11342-8:2016 hoàn toàn tương đương với IEC 62132-8:2012;

TCVN 11342-8:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E3 *Thiết bị điện tử dân dụng* biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 11342 (IEC 62132), Mạch tích hợp gồm các phần sau:

- 1) TCVN 11342-1:2016 (IEC 62132-1:2015), Mạch tích hợp – Đo miễn nhiễm điện từ – Phần 1: Điều kiện chung và định nghĩa
- 2) TCVN 11342-2:2016 (IEC 62132-2:2010), Mạch tích hợp – Đo miễn nhiễm điện từ – Phần 2: Đo miễn nhiễm bức xạ – Phương pháp buồng TEM và buồng TEM băng tần rộng
- 3) TCVN 11342-3:2016 (IEC 62132-3:2006), Mạch tích hợp – Đo miễn nhiễm điện từ – Phần 3: Phương pháp bơm dòng điện lớn
- 4) TCVN 11342-4:2016 (IEC 62132-4:2006), Mạch tích hợp – Đo miễn nhiễm điện từ – Phần 4: Phương pháp bơm trực tiếp công suất RF
- 5) TCVN 11342-5: 2016 (IEC 62132-5:2005), Mạch tích hợp – Đo miễn nhiễm điện từ – Phần 5: Phương pháp lồng faraday trên bàn thử
- 6) TCVN 11342-8: 2016 (IEC 62132-8:2012), Mạch tích hợp – Phần 8: Đo miễn nhiễm điện từ – Phương pháp mạch dải IC
- 7) TCVN 11342-9:2016 (IEC 62132-9:2014), Mạch tích hợp – Phần 9: Đo miễn nhiễm bức xạ – Phương pháp quét bề mặt

Mạch tích hợp – Đo miễn nhiễm điện từ –

Phần 8: Đo miễn nhiễm bức xạ – Phương pháp mạch dải IC

Integrated circuits – Measurement of electromagnetic immunity –

Part 8: Measurement of radiated immunity – IC stripline method

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đo độ miễn nhiễm điện từ của mạch tích hợp (IC) với các nhiễu điện từ bức xạ tần số radiô (RF) trên dải tần 150 kHz đến 3 GHz.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất (kể cả các sửa đổi).

IEC 60050 (all parts), *International Electrotechnical Vocabulary* (available at <http://www.electropedia.org>)
(*Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế*)

IEC 62131-1:2006, *Integrated circuits – Measurement of electromagnetic immunity, 150 kHz to 1 GHz – Part 1: General conditions and definitions* (*Mạch tích hợp – Đo miễn nhiễm điện từ, 150 kHz đến 1 GHz – Phần 1: Điều kiện chung và định nghĩa*)¹

IEC 61000-4-20, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-20: Testing and measurement techniques – Emission and immunity testing in transverse electromagnetic (TEM) waveguides* (*Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-20: Kỹ thuật thử nghiệm và đo lường – Thử nghiệm phát xạ và miễn nhiễm trong ống dẫn sóng điện từ ngang (TEM)*)

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này, áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa trong IEC 62132-1, Điều 3, IEC 60050-131 và IEC 60050-161 và các định nghĩa dưới đây.

3.1

Phương thức điện từ ngang (transverse electromagnetic mode)

(TEM)

Phương thức dẫn sóng theo đó các thành phần trường điện và trường từ theo hướng truyền nhỏ hơn nhiều so với các thành phần trường ban đầu đi qua bất kỳ mặt cắt ngang nào.

¹ Hệ thống Tiêu chuẩn Quốc gia đã có TCVN 11342-1:2016 hoàn toàn tương đương với IEC 62132-1:2015.